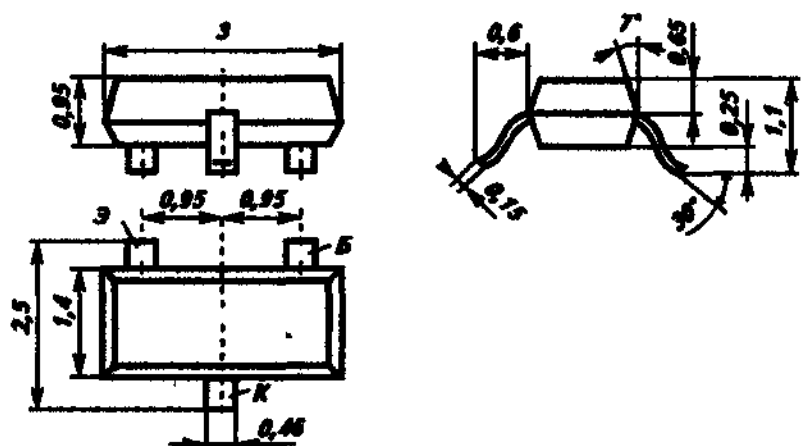


# □ 2Т3130А9, 2Т3130Б9, 2Т3130В9, 2Т3130Г9, 2Т3130Д9, 2Т3130Е9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения во входных каскадах низкочастотных радиотехнических устройств с низким уровнем шумов, в усилителях, генераторах и стабилизаторах напряжения. Выпускаются в миниатюрных пластмассовых корпусах, тип корпуса КТ-46. Масса транзистора не более 0,01 г.



## Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте 1 кГц при  $U_{кб} = 6 В$ ,  $I_b = 0,2 мА$ ,  $R_{сб} = 2 кОм$ :  
 2Т3130Д9 ..... 1,6...4 дБ  
 2Т3130Е9 ..... 1,4...4 дБ  
 Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при  $U_{кб} = 5 В$ ,  $I_b = 2 мА$ ,  $T = +25^{\circ}C$ :  
 2Т3130А9 ..... 100...250  
 2Т3130Б9 ..... 200...500

2Т3130В9 .....	200...500
2Т3130Г9 .....	400...1000
2Т3130Д9 .....	200...500
2Т3130Е9 .....	400...1000

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте

при  $U_{кб} = 5 В$ ,  $I_b = 10 мА$ :

2Т3130А9 .....	2...4,3
2Т3130Б9 .....	2...4,5
2Т3130В9 .....	2...5,1
2Т3130Г9 .....	3...5,3
2Т3130Д9 .....	2...5,2
2Т3130Е9 .....	3...5,5

Граничное напряжение при  $I_k = 10 мА$ ,  $T = +25^{\circ}C$ , не менее:

2Т3130А9, 2Т3130Б9 .....	30 В
2Т3130В9, 2Т3130Д9 .....	20 В
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 .....	15 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_k = 10 мА$ ,

$I_c = 1 мА$ , не более ..... 0,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_k = 10 мА$ ,

$I_c = 1 мА$ , не более ..... 1,2 В

Обратный ток коллектора, не более:

$T = +25^{\circ}C$ 2Т3130А9, 2Т3130Б9 при $U_{кб} = 50 В$ .....	0,1 мкА
2Т3130В9, 2Т3130Д9 при $U_{кб} = 30 В$ .....	0,1 мкА
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 при $U_{кб} = 20 В$ .....	0,1 мкА
$T = +85^{\circ}C$ 2Т3130А9, 2Т3130Б9 при $U_{кб} = 50 В$ .....	1 мкА
2Т3130В9, 2Т3130Д9 при $U_{кб} = 30 В$ .....	1 мкА
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 при $U_{кб} = 20 В$ .....	1 мкА
$T = -60^{\circ}C$ 2Т3130А9, 2Т3130Б9 при $U_{кб} = 50 В$ .....	0,1 мкА
2Т3130В9, 2Т3130Д9 при $U_{кб} = 30 В$ .....	0,1 мкА
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 при $U_{кб} = 20 В$ .....	0,1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{кб} = 5 В$ , не более .....	5 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

2Т3130А9, 2Т3130Б9 .....	50 В
2Т3130В9, 2Т3130Д9 .....	30 В
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 .....	20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

2Т3130А9, 2Т3130Б9 .....	40 В
2Т3130В9, 2Т3130Д9 .....	20 В
2Т3130Г9, 2Т3130Е9 .....	15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база ..... 5 В

Постоянный ток коллектора ..... 100 мА

Постоянный ток базы ..... 20 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup>

при  $T = -60...+25^{\circ}C$  ..... 0,2 Вт

Температура p-n перехода .....  $+85^{\circ}C$

Температура окружающей среды .....  $-60^{\circ}C...+85^{\circ}C$

<sup>1</sup> При  $T = +25...+85^{\circ}C$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется

из выражения:

$$P_{к макс} = (125 - T) / 500, Вт$$

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре методом пайки. Пайку выводов рекомендуется производить: а) одноразовым погружением в припой — ПОС-61 (или "волну" припоя) при температуре не выше  $+265^{\circ}C$  и не более 4 с. б) сплавлением паяльной (лудящей) пасты ПЛ112 при нагреве вывода в месте пайки до температуры не выше  $+190^{\circ}C$  не более 30 с или до температуры не выше  $+230^{\circ}C$  не более 15 с. Расстояние от корпуса до места лужения выводов и пайки (по длине вывода) не менее 0,15 мм.

